

СОДЕРЖАНИЕ

Физика конденсированного состояния

- Коротаев С.М., Морозов А.Н., Сердюк В.О., **Сорокин М.О.** Проявление макроскопической пелокальности в некоторых естественных диссипативных процессах..... 3
- Красильников Н.А., Амирханов Н.М., Исламгалиев Р.К., Валиев Р.З. Влияние степени интенсивной деформации и нагрева на эволюцию структуры композита на основе меди 15
- Колобов Ю.Р., Найденкин Е.В., Дударев Е.Ф., Бакач Г.П., Почивалов Ю.И., Гирсова Н.В., Иванов М.Б. Влияние интенсивной пластической деформации на структуру и механические свойства сплавов системы Al-Mg-Li..... 23

Математическая обработка данных физического эксперимента

- Гладких Б.А., Потапов Ю.В. Начальное приближение для псевдогиперболического метода местоопределения..... 28
- Глухова Е.В., Шкуркин А.С. Оценка характеристик пуассоновского потока заявок по наблюдениям над периодом занятости в системе $M/G/\infty$ при экспоненциальном законе убывания незавершенной работы 34
- Скворцов А.В., Костюк Ю.Л. Сжатие координат узлов триангуляции..... 39

Оптика и спектроскопия

- Гавва С.П. Ангармонические молекулярные параметры возбужденных колебательных состояний..... 43
- Жабина Е.А., Онопенко Г.А., Улеников О.Н., Бюргер Г., Джерзембек В. Анализ колебательно-вращательной структуры полос $2\nu_1$, $\nu_1+\nu_3$ и $2\nu_3$ молекулы D_2Se 48
- Онопенко Г.А. Исследование тонкой вращательной структуры четвертого обертона ($500; A_1, E$) молекулы AsH_3 53

Физика полупроводников и диэлектриков

- Ивонин И.В., **Красильникова Л.М.**, Лаврентьева Л.Г., Пороховниченко Л.П. Исследование поверхностных процессов при газофазовой эпитаксии GaAs: асимметричный захват атомов в ступень 58
- Джакели В.Г.**, Качлишвили З.С., Хизанишвили М.Г., Хизанишвили Э.Г. Комбинационные механизмы ионизации и рекомбинации и генерационно-рекомбинационные процессы в полупроводниках..... 62
- Кревчик В.Д., Грунин А.Б., Семенов М.Б. Примесное поглощение света в структурах с квантовыми точками во внешнем магнитном поле..... 69
- Войцеховский А.В., Коханенко А.П., Несмелов С.Н., Соколов В.Н. Режимы ограничения пороговых характеристик ИК-фотоприемников на основе барьеров PtSi-Si с поверхностным высоколегированным слоем..... 74

Физика элементарных частиц и теория поля

- Гаврилов А.Е. Использование преобразований Лоренца в ненерцшальных системах отсчёта 78
- Ласуков В.В. Квантовое рождение Вселенной 88
- Федосин С.Г., Ким А.С. Момент импульса и радиус протона..... 93